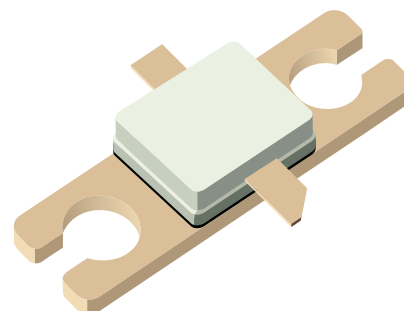


Мощный СВЧ GaN транзистор с напряжением питания 28 В
 Герметизирован в металлокерамическом корпусе КТ-81С
 Предназначен для работы в усилителях мощности до 6000 МГц

- Выходная мощность $P_{\text{вых}} = 5 \text{ Вт}$
- Напряжение питания $U_{\text{си}} = 28 \text{ В}$
- Коэффициент усиления по мощности $K_{\text{ур}} \geq 16,0 \text{ дБ}$
- КПД стока $\eta_c \geq 50 \%$



Предельно допустимые значения электрических режимов эксплуатации

Максимально допустимый постоянный ток стока	$I_c \text{ макс}$	1,0	А
Максимально допустимый прямой ток затвора	$I_z \text{ (пр) макс}$	2,0	мА
Максимально допустимое постоянное напряжение сток-исток	$U_{\text{си макс}}$	130*	В
Напряжение затвор-исток	$U_{\text{зи}}$	-10 до +2	В
Максимально допустимая температура перехода	$t_{\text{п макс}}$	225	°С
Диапазон рабочих температур		-60 до +125	°С
Тепловое сопротивление переход-корпус транзистора	$R_{\text{т п-к}}$	**	°С/Вт

* При температуре корпуса 25°С

** Уточняется в ходе проведения испытаний

Электрические параметры транзисторов

Параметр	Обозначение	Режим измерения	Не менее	Тип.	Не более	Единица измерения	Температура среды (корпуса), °С
Остаточный ток стока	$I_c \text{ ост}$	$U_{\text{си}}=80 \text{ В};$ $U_{\text{зи}}=-8 \text{ В}$	-	-	1,0	мА	25±10
Крутизна характеристики	S	$U_{\text{си}}=10 \text{ В};$ $I_c=0,4 \text{ А}$	0,4	0,6	-	А/В	25±10
Ток стока насыщения	$I_c \text{ нас}$	$U_{\text{си}}=6 \text{ В};$ $U_{\text{зи}}=2 \text{ В}$	1,6	2,0	-	А	25±10
Выходная мощность	$P_{\text{вых}}$	$f=4000 \text{ МГц};$ $U_{\text{си}}=28 \text{ В}$ $P_{\text{вых}}=0,13 \text{ Вт}$ $I_c=0,1 \text{ А}$	5	7	-	Вт	(25±15)
Коэффициент усиления по мощности	$K_{\text{ур}}$	$f=4000 \text{ МГц};$ $U_{\text{си}}=28 \text{ В};$ $P_{\text{вых}}=5 \text{ Вт}$ $I_c=0,1 \text{ А}$	16,0	17,5	-	дБ	(25±15)
КПД стока	η_c	$f=4000 \text{ МГц};$ $U_{\text{си}}=28 \text{ В};$ $P_{\text{вых}}=5 \text{ Вт};$ $I_c=0,1 \text{ А}$	50	55	-	%	(25±15)

Габаритный чертеж

